PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-274005

(43)Date of publication of application: 30.09.1992

(51)Int.CI.

G11B 5/09 G01P 15/12 G11B 20/18

(21)Application number: 03-034905

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing:

01.03.1991

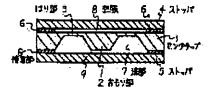
(72)Inventor:

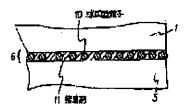
MIYANO SOICHIRO

(54) SEMICONDUCTOR ACCELERATION SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the effect of not requiring working for forming a spacing to stoppers as the spacings between the stoppers and weight parts are determined by the diameter of fine spherical particles. CONSTITUTION: Adhesive parts 6 formed by mixing the fine spherical particles 10 having a uniform diameter and an adhesive 11 are formed at the time of adhering the stoppers 4, 5 to the top and bottom of a sensor chip 1. Gaps 8, 9 can, therefore, be maintained while the surfaces of the stoppers 4, 5 remain flat.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-274005

(43)公開日 平成4年(1992)9月30日

(51) Int.Cl.5		識別記号		庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G11B	5/09	361	F	8322-5D		
G 0 1 P	15/12			8708-2F		
G11B	20/18	1 0 1	Z	9074-5D		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

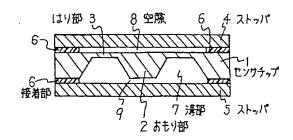
		毎旦明ぶ 木朗ぶ 胡ぶ項の数3(主 3 貝)
(21)出願番号	特願平3~34905	(71)出願人 000004237 日本電気株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)3月1日	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 宮野 壮一郎 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式 会社内
		(74)代理人 弁理士 内原 晋

(54)【発明の名称】 半導体加速度センサ

(57)【要約】

【構成】センサチップ1の上下にストッパ4,5を接着するに際し、直径の均一な球状微粒子10を接着剤11と混合した接着部6を形成する。このため、ストッパ4,5の表面は平らのままで、空隙8,9を保つことができる。

【効果】ストッパ4,5とおもり部2との間の間隙が球状微粒子10の直径で決まるので、ストッパ4,5には間隙を形成するための加工を不要にできるという効果がある。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板に3次元加工を施して両もち のはり部とおもり部とを形成してなるセンサチップと、 前配センサチップのおもり部の過振動による破壊を防止 するために前記センサチップの上下に設けた2つのスト ッパと、前記センサチップおよび前記2つのストッパ間 を接着するための直径が均一な球状微粒子および接着剤 の混合物からなる接着部とを有することを特徴とする半 導体加速度センサ。

【請求項2】 前記センサチップは表面に複数のゲージ 10 抵抗からなる抵抗列を複数組配置していることを特徴と する請求項1記載の半導体加速度センサ。

(請求項3) 前記球状微粒子は硬質プラスチック微粒 子を用いることを特徴とする請求項1記載の半導体加速 度センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体加速度センサに関 し、特に両もちのおもり部を有する半導体加速度センサ に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の半導体加速度センサは、 移動体等に用いられている。

【0003】図3はかかる従来の一例を示す半導体加速 度センサの断面図である。図3に示すように、従来のセ ンサはおもり部2と両もちのはり部3を形成するために 講部7を形成したセンサチップ1の上下にストッパ4. 5を接着している。これらのストッパ4、5はおもり部 2の過大振幅によるはり部3の破壊を防ぐために、おも り部2と極めて微少な間隙8,9を形成する。このた30ップ微粒子で直径 $5\sim20~\mu m$ で均一なものを用いる。 め、ストッパ4、5は必要とされる間隙8、9の厚さだ けセンサチップ1に接着する面から掘り下げる加工が施 される。また、接着にあたっては、接着の厚さを出来る 限り薄くする必要から、静電接着・金ーシリコン共晶接 合・金ー金拡散接合等が用いられている。これらストッ パ4, 5の材質としては、パイレックスガラスやシリコ ン板等が用いられる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の半導体 加速度センサは、ストッパ自体におもり部との間隙を確 40 部2を形成してもよい。 保するための加工が必要になるという欠点があり、また 金ーシリコン共晶接合・金ー金拡散接合にあたっては接 着のための金パターンの形成も必要になる等の欠点があ

【0005】本発明の目的は、かかるセンサチップを挟 むストッパの加工を簡略化し、また接着のための加工を 不要にする半導体加速度センサを提供することにある。 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体加速度セ ンサーは、半導体基板に3次元加工を施して両もちのは 50 【図2】図1に示す接着部の拡大図である。

り部とおもり部とを形成してなるセンサチップと、前記 センサチップのおもり部の過振動による破壊を防止する ために前記センサチップの上下に設けた2つのストッパ と、前記センサチップおよび前記2つのストッパ間を接 着するための直径が均一な球状微粒子および接着剤の混

2

[0007]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を用いて 説明する。

合物からなる接着部とを有して構成される。

【0008】図1は本発明の一実施例を示す半導体加速 度センサの断面図である。図1に示すように、本実施例 はおもり部2と両もちのはり部3を形成し且つおもり部 2の周囲に溝部7を形成したセンサチップ1を有する。 このセンサチップ1の上部及び下部には、それぞれスト ッパ4,5が接着される。このストッパ4,5はセンサ チップ1のおもり部2が震動により必要以上に変位し、 はり部3の破壊を防止するために設けられている。これ らストッパ4,5とセンサチップ1を接着する接着部6 は均一な直径の球状微粒子を接着剤に混合した物により 20 形成される。これにより、ストッパ4,5およびセンサ チップ1間には、一定の間隙8,9 (例えば、10~2 0 μm) が形成され、センサチップ1のおもり部2がこ の間隙以上に変位することを防止している。

【0009】図2は図1に示す接着部の拡大図である。 図2に示すように、ここではセンサチップ1と下側のス トッパ5を接着する接着部6を示す。特に、空隙8、9 を規制する間隙の大きさは、接着部6の接着剤11とと もに用いられる球状微粒子10の直径により決定され る。ここに用いられる球状微粒子10は、硬質プラスチ

【0010】図3は図1に示すセンサチップの上面図で ある。図3に示すように、本実施例のセンサチップ1は ピエゾ抵抗型半導体加速度センサーであり、はり部3の 上に拡散プロセスにより形成される。すなわち、はり部 3のたわみを検出するためのゲージ抵抗12が4本形成 され、ブリッジ回路を構成するために、4本のゲージ抵 抗12間が接続され且つパッド13と接続されている。 かかるピエゾ抵抗型の半導体加速度センサの他にも、シ リコンを3次元加工することにより、はり部3とおもり

[0011]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の半導体加 速度センサは、ストッパ自体におもり部との間隙を形成 するための加工を不要にするだけでなく、センサチップ との接着のための加工を加える必要をなくし、安価に製 造できるという効果がある。

(図面の簡単な説明)

【図1】本発明の一実施例を示す半導体加速度センサの 断面図である。

3

- 【図3】図1に示すセンサチップの上面図である。
- 【図4】従来の一例を示す半導体加速度センサの断面図である。

【符号の説明】

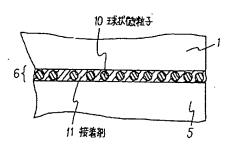
- 1 センサチップ
- 2 おもり部
- 3 はり部
- 4,5 ストッパ

- 6 接着部
- 7 溝部
- 8,9 空隙
- 10 球状微粒子
- 11 接着剤
- 12 ゲージ抵抗
- 13 パッド

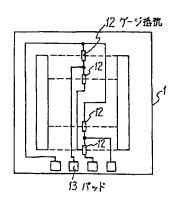
[図1]

はり部 3 8 空阪 6 4 ストッパ 6 でンサラップ 度着部 7 港部 5 ストッパ 2 まもり部

[図2]



[図3]



[図4]

